

# 2SD721, 2SD722

## ■シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

☆2SB711、2SB712とコンプリメンタリペアになります。

☆ダーリントントランジスタ

☆レジンモールドケース

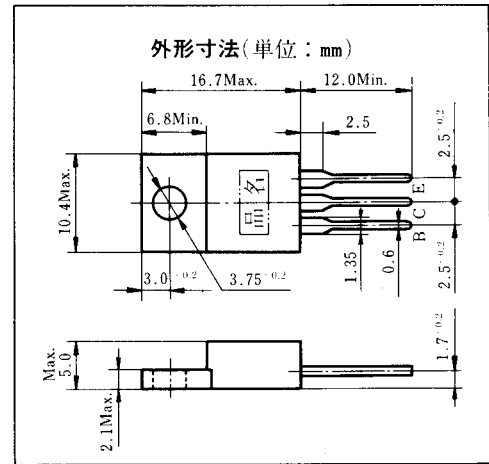
○一般用

○通信産業用

## ■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SD721	2SD722
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB0</sub>	100 V	120 V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CE0</sub>	80 V	100 V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EB0</sub>	6 V	
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	6 A (*Pulse10A)	
ベース電流	I <sub>B</sub>	1 A	
許容コレクタ損失	P <sub>c</sub>	50 W (フランジ温度25°C)	
接合部温度	T <sub>j</sub>	150°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150°C	

\*Pulse:10mSec.以下, Duty cycle 50%以下



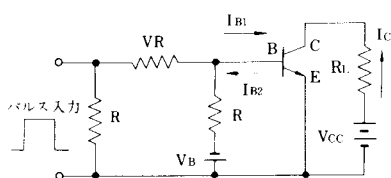
## ■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SD721	2SD722
最大コレクタしゃ断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =	100 μA	100 μA
			100 V	120 V
最大エミッタしゃ断電流	I <sub>EB0</sub>	V <sub>EB</sub> = 6 V	10 mA	
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CE0</sub>	I <sub>C</sub> = 10 mA	80 V	100 V
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = 4 V I <sub>C</sub> = 7 A	500 Min.	
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = 5 A I <sub>B</sub> = 10 mA	1.5 V Max.	

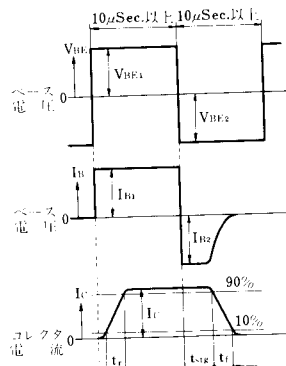
## ■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (Ω)	I <sub>C</sub> (A)	I <sub>B1</sub> (mA)	I <sub>B2</sub> (mA)	t <sub>r</sub> (μSec.)	t <sub>stg</sub> (μSec.)	t <sub>f</sub> (μSec.)
20	4	5	20	-20	1.8	5.5	11

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

